

**0982學期 課程基本資料**

系所 / 年級 資工系碩士班 2年級 課號 / 班別 65M00028 / C

學分數 1學分 選 / 必修 必修

科目中文名稱 產業專題研討 科目英文名稱 Device physics and soi technology

主要授課老師 許健 開課期間 一學年之下學期

人數上限 20 人 已選人數 8人

**起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間**

第1週 / 第18週 / 1526 / 星期4第06節

請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。

**教學綱要**

一、教學目標(Objective) To teach student power device physics and simulation and to develop Pre-silicon process

二、先修科目(Pre Course) Device physics

三、教材內容(Outline) None

四、教學方式(Teaching Method) Lecturing and presentations

五、參考書目(Reference) None

- 1900/1/1 UHV device theory
- 1900/1/1 UHV device theory
- 1900/1/1 UHV device theory
- 1900/1/1 Highside LDMOS device
- 1900/1/1 Highside LDMOS as passing element
- 1900/1/1 Highside LDMOS as passing element
- 1900/1/1 Highside LDMOS as passing element
- 1900/1/1 Lowside LDMOS device as level shifter
- 1900/1/1 Lowside LDMOS device as level shifter
- 1900/1/1 HVI technology

**六、教學進度(Syllabi)**

1900/1/1 HVI device structure and theory  
1900/1/1 HVI device structure and theory  
1900/1/1 HVI device structure and theory  
1900/1/1 UHV SOI device physics and technology  
1900/1/1 UHV SOI device physics and technology  
1900/1/1 UHV SOI device physics and technology  
1900/1/1 Final Presentations  
1900/1/1 Final Presentations

七、評量方式(**Evaluation**)      Final presentations

八、講義位址(**http://**)

九、教育目標